

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:.....

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống:)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng

Ngành: Vật lý; Chuyên ngành: Khoa học Vật liệu.

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Đình Lâm

2. Ngày tháng năm sinh: 01/02/1977; Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Số nhà 14, Trần Quý Kiên, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0902 233 144;

E-mail: lamnd2005@vnu.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ tháng, năm 09,2000 đến tháng, năm 07,2018: Giáo viên thực hành tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Từ tháng, năm 02,2009 đến tháng, năm 02,2014: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Ajou

Chức vụ hiện nay: Giảng viên; Chức vụ cao nhất đã qua: Giảng viên

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ cơ quan: 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại cơ quan:

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): Không có

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 20 tháng 07 năm 2000, số văn bằng: c227654, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý Chất rắn; Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

- Được cấp bằng ThS [4] ngày 03 tháng 03 năm 2006, số văn bằng: 2202, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật lý Chất rắn; Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

- Được cấp bằng TS [5] ngày 21 tháng 02 năm 2014, số văn bằng: 1270, ngành: Kỹ thuật điện, chuyên ngành: Kỹ thuật điện và máy tính; Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Trường Đại học Ajou, Hàn Quốc

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HDGS cơ sở: Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HDGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Vật liệu nhân tạo kích thước nano trong ứng dụng phát triển xanh như pin quang điện, tách nước, siêu tụ điện, chuyển hóa CO₂ thành nhiên liệu, xử lý môi trường...
- Vật liệu chuyển đổi ngược (upconversion) trong ứng dụng chuyển đổi năng lượng và y sinh.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;

- Đã hướng dẫn (số lượng) 6 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này);

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 3 cấp Bộ;

- Đã công bố (số lượng) 32 bài báo khoa học, trong đó 20 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;

- Số lượng sách đã xuất bản 0, trong đó 0 thuộc nhà xuất bản có uy tín;

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: 0

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
Không có			

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:

- Tôi tự nhận thấy bản thân là người có trách nhiệm và tận tụy với vai trò là một nhà giáo. Luôn có ý thức tổ chức và chấp hành kỷ luật cao; luôn cố gắng cập nhật những kiến thức mới, có tính thực tiễn để đáp ứng cho nghiên cứu và giảng dạy. Luôn thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy theo mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục theo quy định của cơ sở đào tạo. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật, các nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo. Luôn đảm bảo uy tín, danh dự của một nhà giáo, tôn trọng người học, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người học. Luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do nhà trường và các đoàn thể tổ chức. Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao về chuyên môn cũng như đảm bảo số giờ dạy trực tiếp trên lớp theo phân công.
- Có 03 năm cuối liên tục tham gia đào tạo bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên và hoàn thành nhiệm vụ và số giờ chuẩn giảng dạy theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, Thông tư số 47/2014/TT- BGDĐT ngày 21/12/2014, Thông tư số 20/2020/TT- BGDĐT ngày 27/07/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo.
- Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: 02 đề tài nghiên cứu cơ bản Quỹ Nghiên cứu khoa học Quốc gia (Nafosted), 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia.
- Hướng dẫn thạc sĩ: 06 thạc sĩ đã được nhận bằng thạc sĩ
- Công bố 32 bài báo trong đó có 20 công trình khoa học công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.
- Căn cứ theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 được sửa đổi bổ sung một số điều tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tôi nhận thấy kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu đã được tích lũy của bản thân hoàn toàn có thể đáp ứng được các tiêu chí xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 15 năm 0 tháng

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đề án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp/số giờ chuẩn gd quy đổi/số giờ chuẩn định mức (*)
		Chính	Phụ			ĐH	SDH	
1	2016-2017			2				0/105/135
2	2017-2018			2		120		120/225/121.5
3	2018-2019		1		2	220.7	60	280.7/432.2/270
03 năm học cuối								
4	2019-2020		1		1	382.25	22.5	404.75/536.98/270
5	2020-2021		1		4	279	37.5	316.5/577.65/270
6	2021-2022	1			4.5	411		411/608.57/270

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.

3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài :

- Học ĐH ; Tại nước: ; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ; Tại nước: Hàn Quốc năm 2014

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước :

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):

d) Đối tượng khác ; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/ CK2/ BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/ CK2/ BSNT	Chính	Phụ			
1	Trần Thị Mùi		X	X		01/2016 đến 06/2016	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội	20/07/2016
2	Lê Thùy Trang		X	X		01/2016 đến 06/2016	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội	20/07/2016
3	Đào Thị Thu Hà		X	X		12/2016 đến 11/2017	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội	30/01/2018

4	Nguyễn Thị Hoa		X	X		12/2016 đến 11/2017	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội	30/01/2018
5	Trương Ngọc Anh		X	X		12/2017 đến 11/2018	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội	26/12/2018
6	Phương Thị Thu Hiền		X	X		12/2017 đến 11/2018	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội	26/12/2018

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDĐH (Số văn bản xác nhận sử dụng sách)
Không có							

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 0 ()

Lưu ý:

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần

ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Xếp loại KQ
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					
1	Chế tạo, khảo sát, và tăng hiệu suất chuyển đổi năng lượng của pin mặt trời sử dụng vật liệu chấm lượng tử	CN	103.99-2014.60, cấp Bộ	01/03/2015 đến 01/03/2018	Số: 171/QĐ-HDQL-NAFOSTED, ngày 15/10/2018, Đạt
2	Nghiên cứu mô phỏng và chế tạo pin mặt trời hữu cơ cấu trúc nano trên cơ sở các lớp P3HT:PCBM và ZnO	CN	QG.19.20, cấp Bộ	01/01/2019 đến 31/12/2020	31/12/2020/Xếp loại: Xuất sắc
3	Chế tạo, khảo sát tính chất của các cấu trúc NaYF ₄ :(Yb,Tm)@AOx/AOx thanh nano/hạt nano (Au, Ag, CuO) với định hướng ứng dụng trong xúc tác quang học hoặc chế tạo pin mặt trời hữu cơ.	CN	103.99-2019.19, cấp Bộ	01/09/2019 đến 31/08/2021	Số: 86/QĐ-HDQL-NAFOSTED, ngày 10/12/2021, Đạt

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỹ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
1	Properties of ZnO:Cu,Co thin film prepared by spin coated method	4	Không	Advances in Natural and Sciences	Q2 - ESCI <i>IF</i> : 2.25		4, 3&4, 231	11/2007
2	Possible origin of ferromagnetism in Co-doped ZnO thin films	5	Không	Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications V, Sept. 2008, Nhatrang, Vietnam			486	09/2008
3	Effects of thermal treated environment on some properties of cobalt-doped zinc oxide fabricated by sol-gel	6	Không	Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications V, Sept. 2008, Nhatrang, Vietnam			331	09/2008

4	Luminescence study of GaN-based vertical light emitting diodes	5	Không	Solid-State and Organic Lighting, ISBN: 978-1-55752-899-5				12/2010
5	Shell layer dependence of photoblinking in CdSe/ZnSe/ZnS quantum dots	6	Không	Applied Physics Letter 0003-6951	Q1 - ISI IF: 3.8	24	98 012109	01/2011
6	Novel Anti-Reflection Technology for GaAs Single-Junction Solar Cells Using Surface Patterning and Au Nanoparticles	7	Không	Journal of Nanoscience and Nanotechnology 1533-4880	Q4 - Scopus IF: 0.8		12 5479	01/2012
7	Enhanced Luminescence of InGaN / GaN Vertical Light Emitting Diodes with an InGaN Protection Layer	6	Có	Proceedings of the international conference Nanomaterials: Applications and Properties			1, 1, 01NTF29- 1	08/2013

8	Influences of InGaP Conical Frustum Nanostructures on the Characteristics of GaAs Solar Cells	4	Có	Journal of Nanomaterials	Q3 - ISI <i>IF: 3.37</i>	6	Article ID 785359	07/2013
9	Improved optical absorption and photocurrent of GaAs solar cells with hexagonal micro-hole array surface texturing	6	Có	Journal of Crystal Growth, 0022-0248	Q2 - ISI <i>IF: 1.8</i>	14	307 244	02/2013
10	Influences of Au Nanoparticle Density on the Performance of GaAs Solar Cells	4	Có	Journal of Korean Physical Society, 0374-4884	Q4 - ISI <i>IF: 0.63</i>	1	64, 6, 868	01/2014
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ								

11	Influences of Sn doping concentration on characteristics of ZnO films for solar cell applications	6	Có	JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, 2354-1059			60, 7, 41	11/2015
12	Influences of growth temperature and solution concentration on hydrothermal preparation of ZnO nanorod	6	Có	JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, 2354-1059			61, 7, 138	07/2016
13	Structural, optical, and electrical properties of undoped and Al doped -ZnO films interesting for photovoltaic devices	6	Có	JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE, 2354-1059			61, 7, 122	07/2016

14	Ge nanopillar solar cells epitaxially grown by metalorganic chemical vapor deposition	5	Không	Scientific Reports 2045-2322	Q1 - ISI IF: 4.54	19	7 42693	02/2017
15	Nghiên cứu tính chất quang xúc tác của lớp chuyển tiếp dị thể p-Si/nZnO/n-ZnO:Sn cấu trúc dây nano chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt	5	Có	Tạp chí khoa học - ĐH Thủ Đô 2354-1504			18 75	09/2017
16	Mechanism of the photocatalytic activity of p-Si(100)/n-ZnO nanorods heterojunction	3	Có	Materials Chemistry and Physics 0254-0584	Q2 - ISI IF: 4.56	11	204 397	10/2017
17	Influences of morphology of window layer on the characteristics of PbS quantum dot solar cells	2	Có	Current Nanoscience 15734137	Q3 - ISI IF: 1.52		14 234	01/2018

18	Characterization of performance parameters of organic solar cells with a buffer ZnO layer	5	Không	Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 2043-6262	Q2 - ESCI IF: 2.25	3	10, 1, 015005	01/2019
19	High thermoelectric power factor in SnSe ₂ thin film grown on Al ₂ O ₃ substrate	7	Không	Mater. Res. Express 2053-1591	Q2 - ISI IF: 1.99	3	6 066420	03/2019
20	Enhanced magneto-transport and thermoelectric properties of MnP nanorod thin films grown on Si (1 0 0)	7	Không	Journal of Magnetism and Magnetic Materials	Q2 - ISI IF: 2.9	6	482 287	03/2019
21	InGaP nano-pattern structure realized by thermally dewetted Au nanoparticles and anisotropic dry etching	1	Có	Current Nanoscience 15734137	Q3 - ISI IF: 1.52	3	16 86	05/2019

22	Influences of PbS quantum dot layers on power conversion efficiency of single junction GaAs solar cells	1	Có	VNU-Journal of Science: Mathematics and Physics, 2615-9341			35, 4, 66	09/2019
23	Influences of growth durations on characteristics of NaYF ₄ :(Yb,Tm) nanocrystals	3	Có	VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 2615-9317		1	35, 4, 104	11/2019
24	Modelling and calculation of characteristic parameters of the active and buffer layers in organic solar cell	2	Có	Current Nanoscience 15734137	Q3 - ISI IF: 1.52		16, 6, 976	02/2020
25	Fabrication and characteristics of Zn _{1-x} Sn _x O nanorod/ITO composite photocatalytic films	7	Có	Mater. Res. Express 2053-1591	Q2 - ISI IF: 1.99		7 045504	04/2020

26	Experimental and numerical study on photocatalytic activity of the ZnO nanorods/CuO composite film	6	Có	Scientific Reports 2045-2322	Q1 - ISI IF: 4.59	7	10 7792	05/2020
27	Characteristics of Zn _{1-x} Al _x O NR/ITO Composite Films Oriented Application for Optoelectronic Devices	1	Có	Electronics 1450-5843	Q4 - Scopus IF: 0.38		24, 1, 43	06/2020
28	SiO ₂ dielectric micro-pattern layer for solar cell application	1	Có	Journal of Surface Science and Technology, 0970-1893	Q4 - Scopus IF: 0.28		36 61	06/2020
29	Modelling and numerical analysis of ZnO/CuO/Cu ₂ O heterojunction solar cell using SCAPS	1	Có	Engineering Research Express 2631-8695	Q3 - Scopus IF: 1.1	10	2 025033	06/2020

30	Ammonia Gas Sensing Characteristic of P3HT-rGO-MWCNT Composite Films	6	Có	Applied science 2076-3417	Q2 - ISI <i>IF: 3.1</i>	2	11 6675	07/2021
31	Influences of ZnO nanorod arrays on photocatalytic activity of n-ZnO nanorods/p-Si heterostructure	1	Có	VNU-Journal of Science: Mathematics and Physics, 2615-9341			37, 4, 11	12/2021
32	Light scattering by noble metallic nanoparticles for performance of compound solar cells enhancement	1	Có	Communication in Physics			32, 1, 21	01/2022

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 10 ([16] [17] [21] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30])

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (*Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg*)

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Thuộc danh mục tạp chí uy tín của ngành	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
----	------------------------	------------	------------------	---	---	----------------	--------------------

Không có

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà UV là tác giả chính sau PGS/TS:

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/ đồng tác giả	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS:

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu TDTT	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Giải thưởng cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

TT	Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN	Vai trò UV (Chủ trì/ Tham gia)	Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)	Cơ quan thẩm định, đưa vào sử dụng	Văn bản đưa vào áp dụng thực tế	Ghi Chú
Không có						

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài báo khoa học quốc tế uy tín*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (UV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): 2016-2017/67.5 (Đề nghị được áp dụng theo Khoản 3, Điều 6 của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 31/8/2018 để tính gấp hai lần điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu đóng góp từ các bài báo khoa học).

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ; 04 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tỉnh Ninh Bình, ngày 23 tháng 06 năm 2022

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

